(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047194 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: 51/40

H01L 51/20,

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAULOHRENTZ; Postfach 3155,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003776

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 53 955.3 19. November 2002 (19.11.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).

- 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen 🕟
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO **FUNCTIONAL LAYERS**

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

- (57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.
 - (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In Internal Application No PCT/DE 03/03776

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	Relevant to claim No.	
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeri circuits and light-emitting di ELECTRON DEVICES MEETING, 1997 DIGEST., INTERNATIONAL WASHING 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, US, 7 December 1997 (1997-12-0 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4	
X .	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHA 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6,		1-4,7
Special call of the constant of the carter to course other than the carter to care of the	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed actual completion of the international search	To later document published after the interpretation or priority date and not in conflict with clied to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot trivolve an inventive step when the description of the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent of mailing of the international second of the international secon	emational filing date the application but eory underlying the claimed invention the considered to cument is taken alone claimed invention wentive step when the one other such docu- us to a person skilled
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Königstein, C	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In actional Application No
PCT/DE 03/03776

		Retevant to claim No.
Charlon of document, with indication, where appropriate, or the recommendation		
DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 TSSN: 0379-6779		1-4
the whole document		8
DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document	-	8
XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document		
KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document		
WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6		1-8
	1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XPO01051921 ISSN: 0379-6779 the whole document DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XPO01051655 ISSN: 0379-6779 the whole document XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XPO01197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XPO01129628 ISSN: 0935-9648 the whole document WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14)	Challon of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 the whole document DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

Indicational Application No PCT/DE 03/03776

Patent document cited in search report		Publication date	Patent tamily member(s)		Publication date	
US 5691089	Α	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999	
WO 03067680	Α	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/20 H01L51/40

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. ALS	WESENTLICH	ANGESEHENE UN	ITERLAGEN
--------	------------	---------------	-----------

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Seiten 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 das ganze Dokument	1-4
X .	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25. November 1997 (1997-11-25) Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Zeile 50 -/	1-4,7

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00dfnahmen bezieht dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdatum ver\u00f6fentlicht worden ist 	 *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des dar Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit eher oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorfe in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheilegend ist *&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenbertchts
15. Juli 2004	22/07/2004

Bevolimächtigter Bediensteter

Königstein, C

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

transitionales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03776

	03/03//6
Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3, 24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921	1-4
ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	8
DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	8
XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	
KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument	
WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6	1-8
	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3, 24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SMITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14)

HATELIAM HORALLIX INCORPROPERTATION

Angaben zu Veröffentlik

. die zur seiben Patentfamilie gehören

In tionales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03776

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung			
•	US	5691089	. A	25-11-1997	US US US	5567550 5677041 5942374	Α	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999	
	MO	03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 03067680		22-08-2003 14-08-2003	